

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
H01L 21/304

(11) 공개번호 특 1997-0077265
(43) 공개일자 1997년 12월 12일

(21) 출원번호	특 1996-0015553
(22) 출원일자	1996년 05월 11일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 김광호
	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지
(72) 발명자	이강현
	서울특별시 송파구 방이동 162-19
	이상원
	경기도 수원시 권선구 세류 2동 1143-9호

심사청구 : 없음

(54) 반도체 장치의 제조에 사용되는 플라즈마 식각장비의 세정방법

요약

반도체 장치의 제조에 사용되는 플라즈마 식각장비의 세정방법을 개시한다. 상기 플라즈마 식각장비의 세정방법은 상기 반도체 장치의 폴리사이드 형성 공정을 진행할 때, 상기 플라즈마 식각장비를 주기적으로 건식세정 하는 단계를 포함한다. 상기 건식 세정은 SF₆ 및 He 가스를 이용하여 수행한다. 본 발명은 플라즈마 건식식각 장비에 건식세정공정을 실시하여 챔버벽에 증착된 폴리머를 효과적으로 제거하여 습식 세정 주기를 증가시키고 소자의 신뢰성 향상을 꾀할 수 있다.

명세서

[발명의 명칭]

반도체 장치의 제조에 사용되는 플라즈마 식각장비의 세정방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

반도체 장치의 제조에 사용되는 플라즈마 식각장비의 세정방법에 있어서, 상기 반도체 장치의 폴리사이드 형성 공정을 진행할 때, 상기 플라즈마 식각장비를 주기적으로 건식 세정 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 식각장비의 세정방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.